

Публикации по теме диссертации Ведущей организации

1. Makhov I.S., Panevin V.Yu., Sofronov A.N. et al. The effect of stimulated interband emission on the impurity-assisted far-infrared photoluminescence in GaAs/AlGaAs quantum wells // *Superlattices and Microstructures*.— 2017.—dec.— Т. 112.— P. 79–85.
2. Akimov V., Firsov D.A., Duque C.A. et al. Temperature shift of intraband absorption peak in tunnel-coupled QW structure // *Optical Materials*. – 2017. – Т. 66. – С. 160-165.
3. Балагула Р.М., Винниченко М.Я., Махов И.С. и др. Фазовая модуляция излучения среднего ИК диапазона в структурах с двойными квантовыми ямами в продольном электрическом поле // *Физика и техника полупроводников*. – 2017. – Т. 51. – №. 3. – С. 378-382.
4. Hanna S., Eichenberg B., Firsov D.A. et al. Electromagnetically induced transparency in a cascade-type quantum well subband system under intense picosecond excitation // *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures*. – 2016. – Т. 75. – С. 93-96.
5. Балагула Р. М., Винниченко М.Я., Махов И.С., Фирсов Д.А., Воробьев Л.Е. Модуляция межподзонного поглощения света и межзонной фотолюминесценции в двойных квантовых ямах GaAs/AlGaAs в сильных продольных электрических полях // *Физика и техника полупроводников*. – 2016. – Т. 50. – №. 11. – С. 1445-1450.
6. Винниченко М. Я. и др. Влияние оже-рекомбинации на концентрацию неравновесных носителей заряда в квантовых ямах InGaAsSb/AlGaAsSb // *Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Физико-математические науки*. – 2016. – №. 4 (253).
7. Махов И. С. и др. Примесная терагерцовая люминесценция в наноструктурах с квантовыми ямами при межзонном фотовозбуждении // *Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Физико-математические науки*. – 2016. – №. 4 (253).
8. Косарев А.Н., Чалдышев В.В., Преображенский В.В., Путятю М.А., Семягин Б.Р. Влияние слоя GaAs, выращенного при низкой температуре, на фотолюминесценцию квантовых точек InAs // *Физика и техника полупроводников*. – 2016. – Т. 50. – №. 11. – С. 1519-1526.
9. Фирсов Д.А., Воробьев Л.Е., Винниченко М.Я., Балагула Р.М., Кулагина М.М., Васильев А.П. Влияние поперечного электрического поля и температуры на поглощение света в туннельно-связанных квантовых ямах GaAs/AlGaAs // *Физика и техника полупроводников*. – 2015. – Т. 49. – №. 11. – С. 1473-1477.
10. Фирсов Д.А., Воробьев Л.Е., Паневин В.Ю. и др. Терагерцовое излучение, связанное с примесными переходами электронов в квантовых ямах при оптической и электрической накачке // *Физика и техника полупроводников*. – 2015. – Т. 49. – №. 1. – С. 30-34.
11. Большаков А.С., Чалдышев В.В., Бабичев А.В. и др. Исследование структур с множественными квантовыми ямами InAs/GaAs методом спектроскопии электроотражения // *Физика и техника полупроводников*. – 2015. – Т. 49. – №. 11. – С. 1448-1452.
12. Lin Y., Wang D., Donetsky D., Kipshidze G., Shterengas L., Vorobjev L.E., Belenky G. Transport properties of holes in bulk InAsSb and performance of barrier long-wavelength infrared detectors // *Semiconductor Science and Technology*. – 2014. – Т. 29. – №. 11. – С. 112002.